

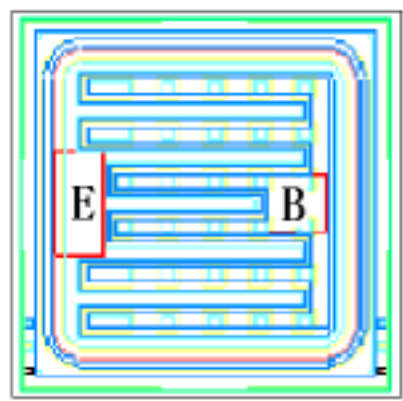


649A 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A080BJ-00
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：800×800μm²
焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SB649A，HS649A，H649A

■ 管芯示意图

■ 极限值 (T_a=25°C) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg}——贮存温度……………-55~150°C
T_j——结温…………… 150°C
P_C——集电极功率耗散 (T_c=25°C) …………… 20W
P_C——集电极功率耗散 (T_A=25°C) …………… 1W
V_{CBO}——集电极—基极电压……………-180V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……………-160V
V_{EBO}——发射极—基极电压……………-5V
I_C——集电极电流……………-1.5A

■ 电参数 (T_a=25°C) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-180			V	I _C =-1mA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	I _C =-10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-1mA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	V _{CB} =-160V, I _E =0
h _{FE}	直流电流增益	60 30		300		V _{CE} =-5V, I _C =-150mA V _{CE} =-5V, I _C =-500mA
V _{CE} (sat)	集电极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	V _{CE} =-5V, I _C =-150mA
f _T	特征频率		140		MHz	V _{CE} =-5V, I _C =-150mA
C _{ob}	共基极输出电容		27		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz